

<<国内外半导体材料标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<国内外半导体材料标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506632874

10位ISBN编号：750663287X

出版时间：2004-3

出版时间：中国标准出版社

作者：屠海令编

页数：1137

字数：2162000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国内外半导体材料标准汇编>>

内容概要

本世纪头20年,我国经济建设的主要任务是推动经济结构战略性调整,基本实现工业化,大力推进信息化,加快建设现代化,保持国民经济持续快速健康发展。

标准化是工业化、信息化和现代化的重要基础,技术标准已经成为国际经济、科技竞争的重要手段。为全面提升我国标准工作的技术水平,适应加入WTO以后在高技术领域所面临的竞争,全国科技工作会议从推进我国“十五”科技发展的高度提出实施“人才、专利、技术标准”三大战略,并在科技部重大专项实施过程中突出强调三大战略的落实。

半导体材料是新材料的重要组成部分,在集成电路产业中发挥着重要支撑作用。

国家科技部在“十五”科技发展计划中,将超大规模集成电路配套材料列为重点发展的12个重大专项内容之一,以0.13-0.10 μm 技术硅集成电路所需配套材料为主攻方向,加强自主创新,根据世界发展趋势,跨越式地有重点地进行研究开发,对市场用量大的微电子配套材料进行工程化技术体系研究,形成专业化和规模化生产。

相关材料标准体系研究是工程化技术体系的重要内容之一。

北京有色金属研究总院等单位在总结现有国内外半导体材料标准基础上,编辑出版的《国内外半导体材料标准汇编》一书,不仅为我国从事半导体材料研究、生产和使用的科研、设计、生产、检测评价、管理、大专院校等各类人员提供了一本内容全面的工具书,而且对推进我国技术标准工作具有重要意义。

值此《国内外半导体材料标准汇编》出版之际,希望北京有色金属研究总院等半导体材料界的技术开发与生产单位能够继续努力,将科技创新活动与标准化工作紧密结合起来,使我国最新的科研成果用标准的形式体现出来,为促进我国半导体材料产业技术进步和行业发展做出新的更大贡献。

<<国内外半导体材料标准汇编>>

书籍目录

- 一、我国半导体材料标准
- 1.基础标准 GB/T 8756-1988 锗晶体缺陷图谱 GB/T 13389-1992 掺硼掺磷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程 GB/T 14264-1993 半导体材料术语 GB/T 14844-1993 半导体材料牌号表示方法 GB/T 16595-1996 晶片通用网络规范 GB/T 16596-1996 确定晶片坐标系规范 YS/T 209-1994 硅材料原生缺陷图谱(原GBn 266-87)
- 2.产品标准 GB/T 2881-1991 工业硅技术条件 GB/T 5238-1995 锗单晶 GB/T 10118-1988 高纯镓 GB/T 1069-1989 高纯二氧化锗 GB/T 11070-1989 还原锗锭 GB/T 11071-1989 区熔锗锭 GB/T 1072-1989 铋化镉多晶、单晶及切割片 GB/T 11093-1989 液封直拉法砷化镓单晶及切割片 GB/T 11094-1989 水平法砷化镓单晶及切割片 GB/T 12962-1996 硅单晶 GB/T 12963-1996 硅多晶 GB/T 12964-2003 硅单晶抛光片 GB/T 12965-1996 硅单晶切割片和研磨片 GB/T 14139-1993 硅外延片 GB/T 15713-1995 锗单晶片 YS/T 13-1991 高纯四氯化锗 YS/T 28-1992 硅片包装 YS/T 43-1992 高纯砷 YS/T 264-1994 高纯镉(原GB 8003-87) Ys/T 290-1994 霍尔器件和甘氏器件用砷化镓液相外延片(原GB 11095-89) YS/T 300-1994 锗富集物(原ZB H 31003-87)
- 3.方法标准 GB/T 1550-1997 非本征半导体材料导电类型测试方法 GB/T 1551-1995 硅、锗单晶电阻率测定 直流两探针法 GB/T 1552-1995 硅、锗单晶电阻率测定 直排四探针法 GB/T 1553-1997 硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法 GB/T 1554-1995 硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法 GB/T 1555-1997 半导体单晶晶向测定方法 GB/T 1557-1989 硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法 GB/T 1558-1997 硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法 GB/T 4058-1995 硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法 GB/T 4059-1983 硅多晶气氛区熔磷检验方法 GB/T 4060-1983 硅多晶真空区熔基硼检验方法 GB/T 4061-1983 硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法 GB/T 4298-1984 半导体硅材料中杂质元素的活化分析方法 GB/T 4326-1984 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法 GB/T 5252-1985 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法 GB/T 6616-1995 半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定非接触涡流法 GB/T 6617-1995 硅片电阻率测定扩展电阻探针法 GB/T 6618-1995 硅片厚度和总厚度变化测试方法 GB/T 6619-1995 硅片弯曲度测试方法 GB/T 6620-1995 硅片翘曲度非接触式测试方法 GB/T 6621-1995 硅抛光片表面平整度测试方法 GB/T 6624-1995 硅抛光片表面质量目测检验方法 GB/T 8757-1988 砷化镓中载流子浓度等离子共振测量方法 GB/T 8758-1988 砷化镓外延层厚度红外干涉测量方法 GB/T 8760-1988 砷化镓单晶位错密度的测量方法 GB/T 11068-1989 砷化镓外延层载流子浓度电容—电压测量方法 GB/T 11073-1989 硅片径向电阻率变化的测量方法 GB/T 13387-1992 电子材料晶片参考面长度测量方法 GB/T 13388-1992 硅片参考面结晶学取向x射线测量方法 GB/T 14140.1-1993 硅片直径测量方法 光学投影法 GB/T 14140.2-1993 硅片直径测量方法 千分尺法 GB/T 14141-1993 硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定直排四探针法 GB/T 14142-1993 硅外延层晶体完整性检验方法腐蚀法 GB/T 14143-1993 300-900nm硅片间隙氧含量红外吸收测量方法 GB/T 14144-1993 硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法 GB/T 14145-1993 硅外延层堆垛层错密度测定干涉相衬显微镜法 GB/T 14146-1993 硅外延层载流子浓度测定汞探针电容—电压法 GB/T 14847-1993 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法 GB/T 14849.1-1993 工业硅化学分析方法 1, 10—二氮杂菲分光光度法测定铁量 GB/T 14849.2-1993 工业硅化学分析方法 铬天青-S分光光度法测定铝量 GB/T 14849.3-1993 工业硅化学分析方法 钙量的测定 GB/T 15615-1995 硅片抗弯强度测试方法二、SEMI标准

<<国内外半导体材料标准汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>